



ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА РЕАКТИВНО-ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ СО ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ПЛАЗМА ТМ 7

Назначение:

Травление тонких диэлектрических и металлических слоёв, а также полупроводниковых материалов методом реактивно-ионного травления.

Особенности:

- Рабочая поверхность стола-ВЧ электрода $\varnothing 150$ мм;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек $\varnothing 75, 100, 150$ мм из кассеты в кассету;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде – подложкодержателе в диапазоне от 0 до 1000 В;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ электрода-подложкодержателя в диапазоне 30-200 Вт;
- Рабочие газы: Ar, SF₆, O₂, CF₄;
- Форвакуумная система откачки;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 3 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой $\sim 2,5$ м².

